

# 2SA661

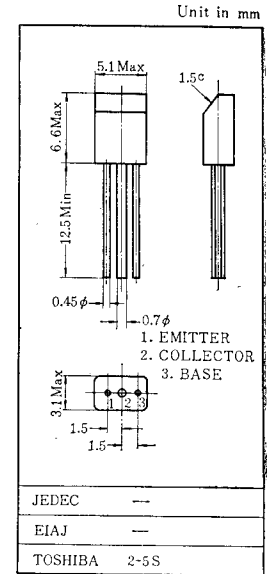
シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR(PCT PROCESS)

- 励振段増幅用 ○ 電圧増幅用  
○ Driver Stage and Amplifier Applications.  
○ High Voltage Amplifier Applications.

- 高耐圧です:  $V_{CE0} \geq -50V$
- 許容コレクタ損失が大きい:  $P_C = 600mW$  ( $T_a = 25^\circ C$ )
- 2SC1166とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1166

### 最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-200	mA
エミッタ電流	$I_E$	200	mA
コレクタ損失	$P_C$	600	mW
接合温度	$T_J$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{STG}$	-55~150	$^\circ C$



アクセサリはRH-16を適用  
RADIATOR HOLDER RH-16

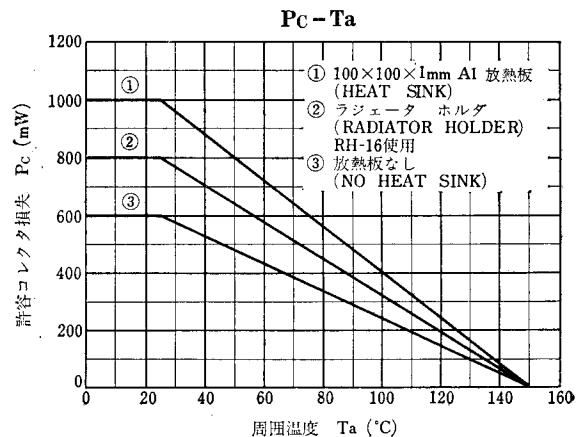
### 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -20V, I_E = 0$	—	—	-100	nA
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-50	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 0.1mA, I_B = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -50mA$	40	100	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100mA, I_B = -10mA$	—	—	-0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	70	100	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	9	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SA661 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA661-R	40	80
2SA661-O	70	140
2SA661-Y	120	240
2SA661-GR	200	400



This datasheet has been downloaded from:

[www.DatasheetCatalog.com](http://www.DatasheetCatalog.com)

Datasheets for electronic components.